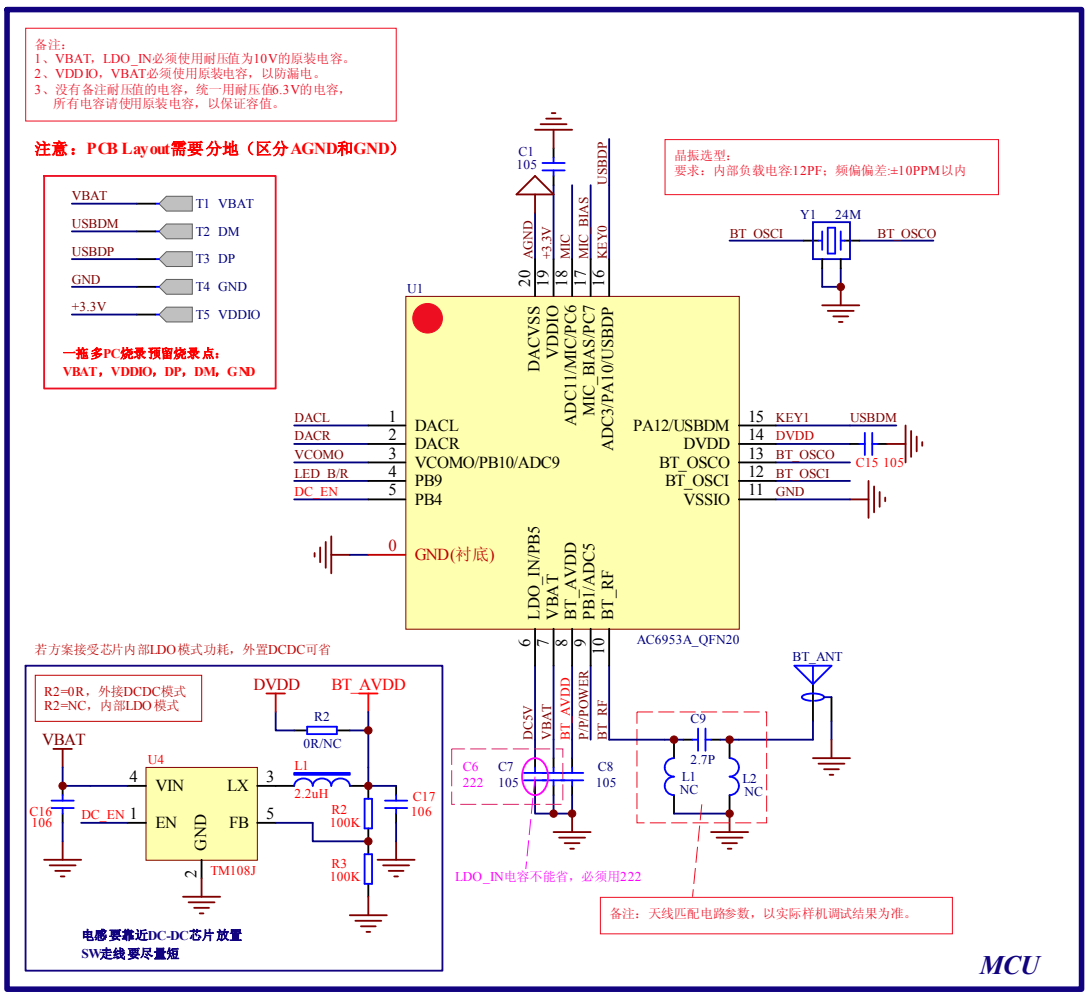
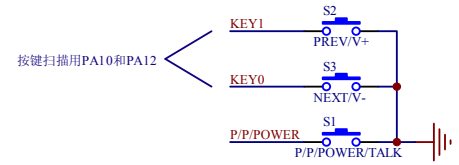
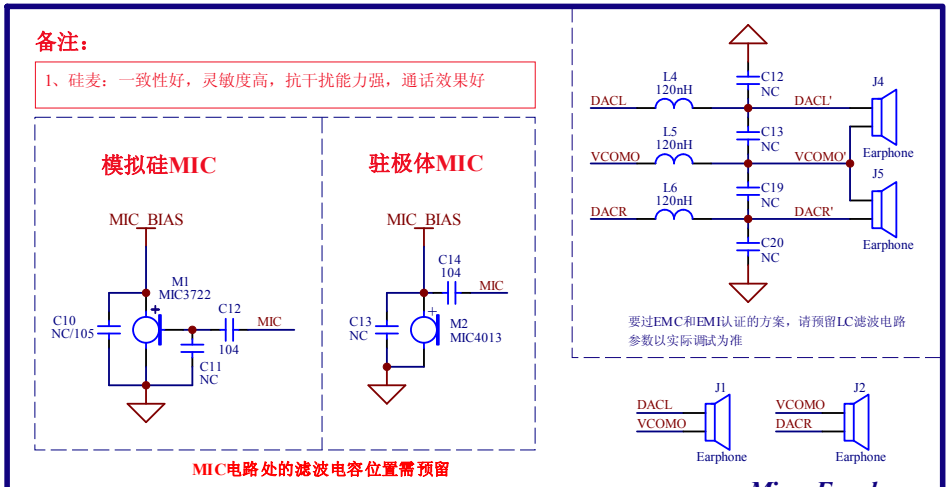
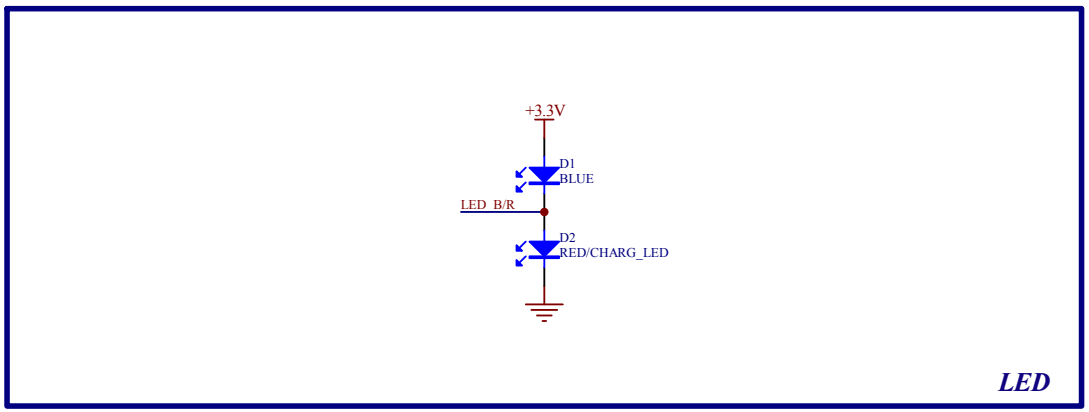
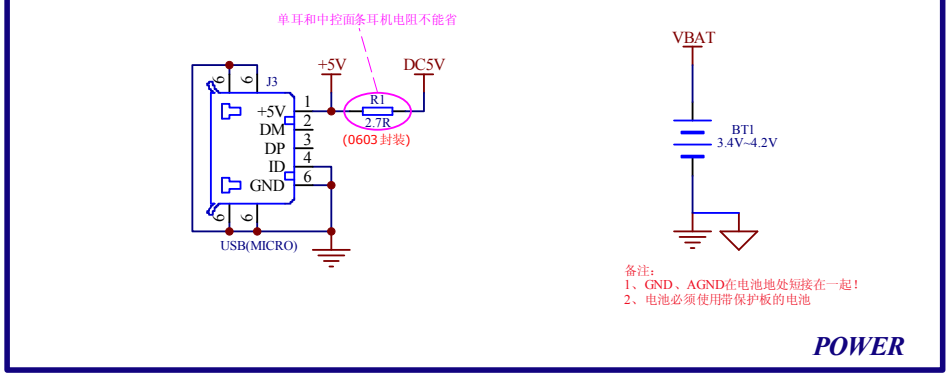

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容12PF；频偏偏差±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
U1
DACL
DACR
VCOMO/PB10/ADC9
PB9
PB4
GND(衬底)
DACVSS
VDDIO
ADC11/MIC/PC6
MIC_BIAS/PC7
ADC3/PA10/USBDP
PA12/USBDM
DVDD
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
LDO_IN/PB5
VBAT
BT_AVDD
PB1/ADC5
BT_RF
AC6953A_QFN20
KEY1
USBDM
DVDD
BT_OSCO
BT_OSCI
GND
C15 105
BT_ANT
若方案接受芯片内部LDO模式功耗，外置DCDC可省
R2=0R，外接DCDC模式
R2=NC，内接LDO模式
DVDD
BT_AVDD
VBAT
R2
0R/NC
U4
VIN
LX
EN
GND
FB
TM108J
L1
2.2uH
C16
106
DC_EN
C17
106
R2
100K
R3
100K
电感要靠近DC-DC芯片放置
SW走线要尽量短
C6
222
C7
105
C8
105
C9
2.7P
L1
NC
L2
NC
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
MCU


按键扫描用PA10和PA12
KEY1
S2
PREV/V+
KEY0
S3
NEXT/V-
P/P/POWER
S1
P/P/POWER/TALK
KEY


备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1
MIC3722
C10
NC/105
C12
104
MIC
C11
NC
驻极体MIC
MIC_BIAS
C14
104
MIC
C13
NC
M2
MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
L4
120nH
L5
120nH
L6
120nH
C12
NC
C13
NC
C19
NC
C20
NC
DACL
VCOMO
DACR
DACL'
VCOMO'
DACR'
J4
J5
Earphone
Earphone
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
J1
J2
DACL
VCOMO
VCOMO
DACR
Earphone
Earphone
Mic、Earphone


+3.3V
D1
BLUE
LED_B/R
D2
RED/CHARG_LED
LED


单耳和中控面条耳机电阻不能省
J3
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
+5V
DC5V
R1
2.7R
(0603封装)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池
POWER